

光敏三极管

概述：

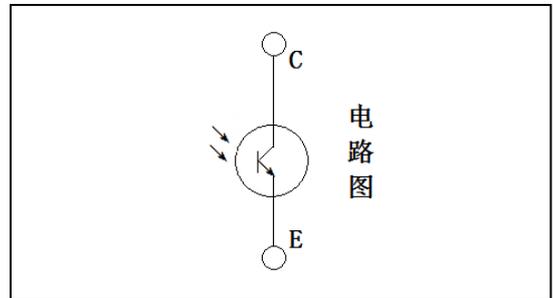
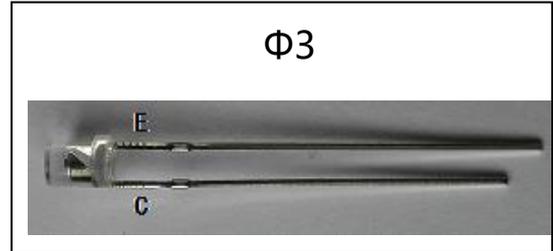
GL400F3, 硅光敏三极管, 采用 CMOS 工艺制造。可应用于远距离接受以及各种识别系统、安保设备。

Φ3 平头封装。

V_{CEO}	30	V
V_{ECO}	5	V
P_C	70	mW
λ	400~1100	nm

特点：

- 高灵敏度
- 低暗电流
- 高耐压



额定值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$):

参数项	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压	V_{CEO}	30	V
发射极-集电极电压	V_{ECO}	5	V
功耗	P_C	70	mW
工作温度	T_{opr}	-25~+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	-40~+100	$^{\circ}\text{C}$

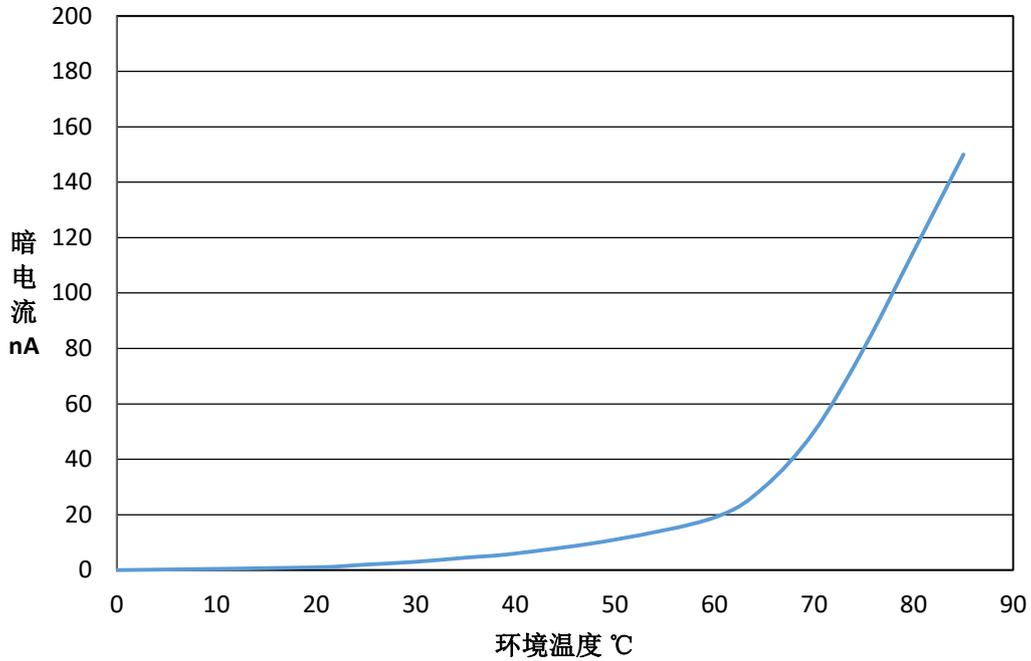
光电特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified):

OFF Characteristics						
参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
感光峰值波长	λ_p	--		850		nm
感光波宽范围	λ	--	400		1100	nm
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	$I_{ce}=100\mu\text{A}$, $E_v=0\text{Lux}$	30			V
发射极-集电极电压	BV_{ECO}	$I_{ec}=100\mu\text{A}$, $E_v=0\text{Lux}$	5			V
饱和压降	$V_{ce}(\text{sat})$	$I_{ce}=1\text{mA}$, $E_v=1000\text{Lux}$			0.3	V
暗电流	I_{ceo}	$V_{ce}=10\text{V}$, $E_v=0\text{Lux}$			100	nA
亮电流	$I_L(1)$	$V_{ce}=5\text{V}$, $E_v=10\text{Lux}$	3		10	μA
	$I_L(2)$	$V_{ce}=5\text{V}$, $E_v=50\text{Lux}$	10		30	μA
开启时间	t_r	$V_{ce}=5\text{V}$, $I_{ce}=1\text{mA}$,		15		μs
关闭时间	t_f	$R_L=100\Omega$		15		μs

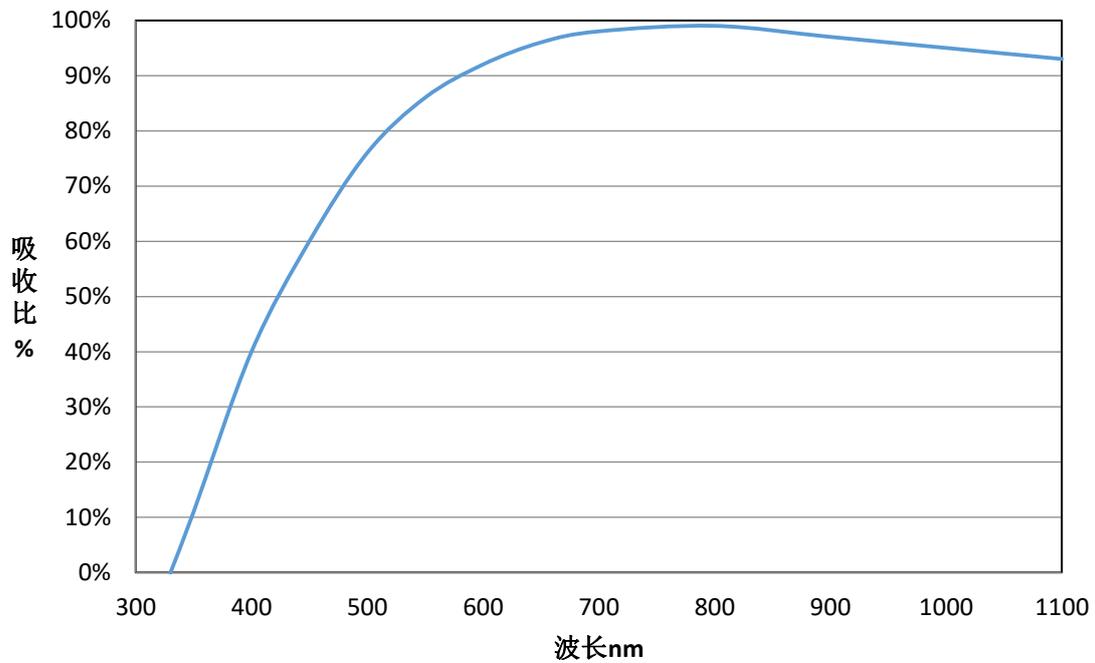


温度与暗电流关系图

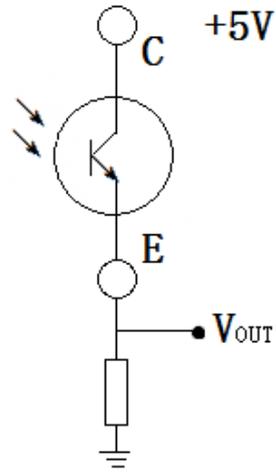
$V_{ce}=5V, E_v=0\text{Lux}$



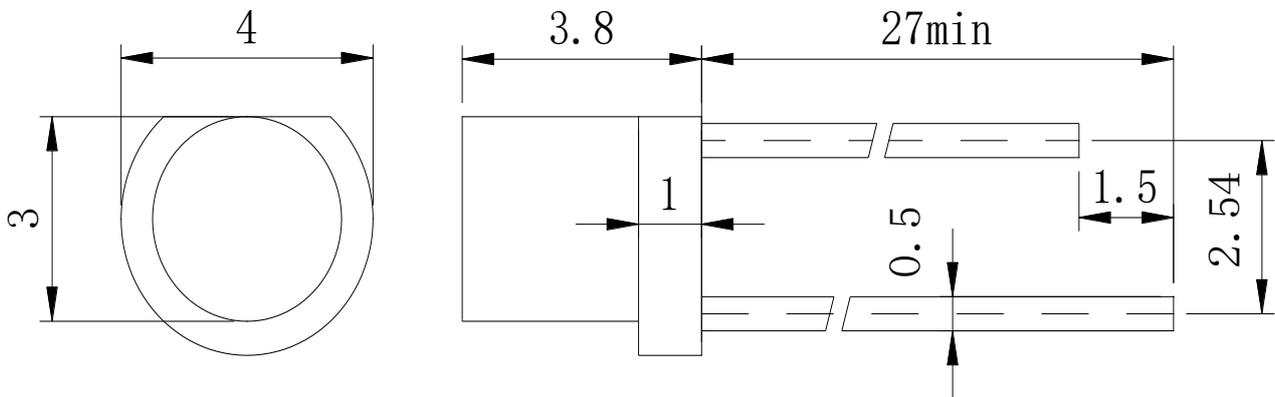
感光特性曲线



光敏三极管 典型应用线路



外形尺寸图（单位：mm）



Company : Wuxi Guang Lei electronic technology co., LTD

TEL : 13961734102 Mr.yuan

Wuxi Guang Lei electronic technology co., LTD